单壁碳纳米管吸附氧分子的电子输运性质理论研究*

赵 佩¹) 郑继明^{2)†} 陈有为³) 郭 平¹) 任兆玉²)

(西北大学物理系,西安 710069)
 (西北大学光子学与光子技术研究所,西安 710069)
 (西安邮电学院网络工程系,西安 710121)
 (2010 年 8 月 9 日收到;2010 年 9 月 14 日收到修改稿)

用基于第一性原理的密度泛函理论和非平衡态格林函数方法对(4,4)单壁碳纳米管及其吸附氧气分子情况下 的平衡态和非平衡态电导性质进行了研究.发现在小于2V的偏压下,系统对电压的增加呈现两种不同增长速率 的电流响应,其中电压小于1.1V时电流增加速率较大;而当电压大于该值后,电流对电压增加速率变缓.吸附的 氧分子提供双重的作用,一方面氧分子提供的能级有利于电子隧穿中心散射区;另一方面氧分子的电子态会破坏 碳管的平移对称性,从而降低电子对系统的透射能力.

关键词:单壁碳纳米管,氧分子吸附,电子输运,非平衡态格林函数 PACS: 85.65.+h,73.63.-b,85.35.Kt

1. 引 言

碳是自然界中存在形式最丰富的元素之一.不 同的形态展现出多样的物理化学性质[1-3]. 就碳纳 米管而言,它可以是金属性或是半金属性的,也可 以是半导体性的,首先取决于它的几何结构. 甚至 在同一根碳纳米管上,由于结构的变化,在碳纳米 管的不同部分也可以呈现出不同的导电性质,从而 具有整流等特性^[4,5]. 给具有结构变化的单壁碳纳 米管加上合适的电极及栅极电压,可以制成在室温 下工作的二极管及场效应三极管^[6,7].通常实验中. 碳纳米管都会暴露于空气中,已经有实验证实,即 使微量的气体吸附都会强烈地影响碳纳米管的结 构,从而影响碳纳米管的导电特性^[8,9]、改变碳纳米 管的场发射特性^[10].小分子吸附为什么会有强烈 的影响? 需要从理论上探讨小分子吸附对单壁碳 纳米管几何及电子结构性质的影响. 目前第一性原 理的理论研究工作主要集中在场发射特性上[11-16]. 但对吸附气体影响碳纳米管输运性质的研究还 较少[17].

本工作主要利用非平衡态格林函数(NEGF)和 密度泛函理论(DFT)对单壁碳纳米管吸附氧分子后 的电子输运性质进行了模拟研究,考察其电子输运 性质在吸附氧分子前后的变化规律.

2. 模型及计算

计算中的模拟模型如图 1 所示,一段(4,4)单 壁碳纳米管夹在左、右两半无限长的相同碳纳米管 电极之间,组成了一个完整的碳纳米管分子结.其 中的单壁碳纳米管为扶手椅型金属管,直径为 5.432 Å,沿轴向的一个单元长为 2.463 Å,包含 16 个碳原子.在该模型中,中心区碳管取两个单元,氧 分子沿着碳纳米管管轴放置.

在实际的理论计算中,该体系常被分为3部分: 左、右半无限长的碳管电极和中心散射区,其中中 心散射区包括电极的部分用以屏蔽中间原子尺度 导体对电极势的影响,从而让中间导体近似地处于 块体势之中^[18].通过中心区导体的电流可以根据 如下 Landauer-Büttiker 公式^[19]积分得到

©2011 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*}陕西省自然科学基金(批准号:2009JQ1004)、国家自然科学基金青年科学基金(批准号:10904123)和陕西省教育厅专项科研计划(批准号:08JK471)资助的课题.

[†]通讯联系人. E-mail: zjm@ nwu. edu. cn

$$I(V) = \frac{2e^2}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}E[f_1(E - u_1)]$$

 $-f_{r}(E-u_{r}) \rceil T(E,V), \qquad (1)$

其中 u_1 和 u_r 分别为左右电极的化学势, f_1, f_r 分别为两个电极的电子分布函数,而T(E, V)是在偏压为V、能量为E时的透射系数.

在整个 DFT 计算中,我们采用了局域密度近 似,交换关联泛函为 Perdew 和 Zunger^[20]所提出的 参数化泛函.根据软件使用的推荐,所有原子的基 组为单ζ(SZ)基组,截断能取 50 Ry.在模型中,氧 分子的初始位置按文献[12]中氧分子的最稳定位 置确定,然后进行了几何优化,使每一原子受力小 于 0.05 eV/Å.所有计算都是通过最近发展起来的 专门用于介观体系电子输运性质研究的 ATK 程序 包完成的^[21,22].



图1 (4,4)单壁碳纳米管吸附氧分子的几何构型

3. 结果及分析

3.1. (4,4) 单壁碳纳米管的 I-V 特性分析

图 2 为计算得到的无限长(4,4)单壁碳纳米管的能带、态密度(DOS)和在无偏压的平衡态下的透射谱. 从能带图和 DOS 图中可以看到:从-2 到 2 eV的能量范围内,DOS 主要由 5 条能带贡献. 其中,DOS 图中-1.75 eV 处的奇点对应来源于能带 1 和 2,而能量较高处的 3 个奇点分别来源于能带 3,4 和 5,如图 2(a)所示. 在透射谱中的峰值对应着 DOS 图的相应峰值,在-1.75 到 1.3 eV 能量范围内,透射曲线基本上是一个处于 2 左右的平台. 大于或小于该能量范围,DOS 图中的奇点由其他能带

贡献,透射相应地跃变到另一平台上.



图 2 碳纳米管在平衡态下的 (a)能带,(b)态密度和(c)透射谱

图 3 为碳纳米管在不同偏压下的 DOS 图和透射谱.加上偏压后,在 DOS 图中两奇点之间的平台 逐渐缩小了伸展的能量范围,原来尖锐的 DOS 峰值 逐步下降,并向高能方向移动,在最高峰的两侧出 现更多小峰,如图 3(a)所示.说明随着电压的增 加,能带在电场作用下会发生移动,一些新的态移 动到了 -2 eV 和2 eV 能量位置的附近.相应地,原 来透射谱中高约为2 的平台随着偏压的增加也逐步 缩小了占据的能量范围,在偏压大于约1.1 V 后,该 平台两侧峰突然变成高约为1 的低平台,如图3(b) 所示.



图 3 碳纳米管在不同偏压下的(a)态密度,(b)透射谱和(c)I-V特性

图 3(c) 是计算出的该系统的 *I-V* 特性关系图. 从图可以看出:*I-V* 曲线呈现两种不同斜率的线性 关系,小偏压下(0—1.1 V),电流随偏压的线性增 加速率较快,而当偏压大于 1.1 V 时,线性变化的斜 率较小.这种 *I-V* 关系中出现转折的现象,与文献 [14]中的计算结果相似.小偏压下 *I-V* 关系对应着 透射谱中高约为2的平台,这个平台既高又比较宽, 所以*I-V*线性变化的斜率大,而当偏压大于1.1 V 时,电流积分的能量范围包含了透射能力约为1的 低平台贡献,所以电流随偏压的线性增加速率明显 下降.

3.2. 吸附氧分子的(4,4) 单壁碳纳米管的 *I-V* 特性 分析

图 4 是计算得到的吸附一个氧气分子的无限长 (4,4)单壁碳纳米管的态密度(DOS)和平衡态透射 谱.可以看出,吸附氧气分子的碳纳米管与未吸附 氧气分子的相比,只在 0 和 1.68 eV 处多出 2 个新 峰.相应地,在透射谱的 0 eV 处会出现凹陷的峰 谷,由于该处对应的 DOS 峰较宽,所以透射谱中的 对应峰谷也较宽、较深,而 1.68 eV 处的透射谱并没 有明显变化.新增的 DOS 峰是由碳纳米管所吸附 的分子贡献的,这些态明显地破坏了碳纳米管的平 移对称性,从而增加了对传导电子的散射,降低了 电子对系统的透射能力,在透射谱的相应能量位置 出现了峰谷.这些讨论也可以从投影态密度图中得 到印证.



图 4 平衡态下氧吸附碳管系统的(a) DOS 和(b)透射谱

图 5 所示为吸附氧气分子的碳纳米管体系在特定能级处的空间分辨 DOS 以及氧气分子前线轨道 图. 计算发现,氧气分子在费米能级(0 eV)附近存在一对由氧的 2p_x和 2p_y分别形成的简并反键轨 道. 从图 5(a)和(b)可以看到,系统在 0 eV 处的 DOS 峰来源于氧气分子的这两个轨道,它们在孤立

分子状态时是简并的,当存在碳纳米管时,由于其 中一个 p 轨道与碳纳米管有较强的耦合(如图 5 (c)),而另一 p 轨道与碳管表面原子平行耦合明显 较弱(如图 5(d)),使得简并解除了.弱耦合的态局 域在较小的能量范围内,对碳管中电子的散射能力 也较弱.



图 5 空间分辨态密度图和分子投影自治哈密顿量图 位于(a)0.0 eV,(b) -0.029 eV 处的空间分辨态密度图,位于(c) -0.00499 eV,(d) -0.029 eV 的分子投影自治哈密顿量图

图 6 为吸附氧分子的碳纳米管在不同偏压下的 DOS 图(a)、透射谱(b)和*I-V*特性曲线(c).加上偏 压后,在 DOS 图中两奇点之间的平台逐渐缩小了伸 展的能量范围,原来尖锐的 DOS 峰值逐步下降,并 稍向高能方向移动,在最高峰的两侧出现更多小 峰,而处于处于原来 0 eV 附近由氧分子两个简并轨 道贡献的 DOS 峰则向低能方向移动.由于氧分子 两个简并轨道在电场作用下发生分离,耦合能力弱 的轨道贡献的 DOS 峰表现得非常尖锐,而耦合能力 强的轨道表现为较宽的 DOS 峰,对应的透射峰谷不 仅深而且展宽的较宽,如图 6(b),从而使得吸附氧 气分子的碳纳米管的电流响应小于同电压下的未 吸附氧分子系统的电流响应.而当偏压增加到 1.7 V 时,氧分子提供的新能级变成有利于碳管中电子 隧穿的通道,吸附系统的电流响应大于同电压下未 吸附系统的电流响应,如图6(c).

4. 结 论

本文用非平衡态格林函数和密度泛函理论的方法,系统地研究了(4,4)单壁碳纳米管及其吸附氧气分子时的输运特性,取得了如下主要结论:1)随着电压的线性增加,电流响应虽然呈现出线性的增长行为,但增长的速度明显分为两段,当偏压大于1.1 V时,电流增长的速度明显地减小.2)吸附氧气分子的(4,4)碳纳米管在0 eV 处会比为未吸附系统的 DOS 多出两个峰,它们分别是由氧分子的一对简并轨道所贡献.这两个简并的分子轨道由于与碳纳米管间的耦合强弱不同,随着偏压的增加逐渐分离.耦合能力强的轨道所贡献的透射峰谷不仅深而且展宽较



图 6 氧分子吸附碳管在不同偏压下的(a) DOS, (b) 透射谱和(c) I-V 曲线

宽,使得吸附氧气分子的(4,4)单壁碳纳米管的电流 响应小于同电压下的未吸附系统的电流响应;而当偏 压增加到1.7 V以后,吸附系统的电流响应会大于同 电压下未吸附系统的电流响应,这是因为吸附的氧分子提供的能级在一定偏压下又成为有利于碳纳米管中电子隧穿的通道,从而一定程度上增强了透射.

- [1] Kroto H W, Heath J R, O'Brien S C, Curl R F, Smalley R E 1985 Nature 318 162
- [2] Iijima S 1991 Nature **354** 56
- [3] Huffman D R 1991 *Phys. Today* **44** 22
- [4] Ouyang M, Huang J L, Cheung C L, Lieber C M 2001 Science 291 97
- [5] Liang W J, Bockrath M, Bozovic D, Hafner J H, Tinkham M, Park H 2001 Nature 411 665
- [6] Tans S J, Verschueren R M A, Ekke C D 1998 Nature 393 49
- [7] Martel R, Schmidt T, Shea H R, Hertel T, Avouris P 1998 Appl. Phys. Lett. 73 2447
- [8] Kong J, Franklin N R, Zhou C, Chapline M G, Peng S, Cho K, Dai H 2000 Science 287 622
- [9] Zhang LJ, Hu H F, Wang Z Y, Wei Y, Jia J F 2010 Acta Phys. Sin. 59 527(in Chinese)[张丽娟、胡慧芳、王志勇、魏 燕、贾 金凤 2010 物理学报 59 527]

- [10] Tang X P, Kleinhammes A, Shimoda H, Fleming L, Bennoune K Y, Sinha S, Bower C, Zhou O, Wu Y 2000 Science 288 492
- [11] Li Z, Wang C Y 2006 Chem. Phys. 330 417
- [12] Jhi S H, Louie S G, Cohen M L 2000 Phys. Rev. Lett. 85 1710
- [13] Liang J W, Hu H F, Wei J W, Peng P 2005 Acta Phys. Sin. 54
 2877 (in Chinese)[梁君武、胡慧芳、韦建卫、彭 平 2005 物 理学报 54 2877]
- [14] Zang Y F, Li Y, Jia G X, Li J J 2005 Acta Chim. Sin. 63 581 (in Chinese)[章永凡、李 奕、贾桂霄、李俊篯 2005 化学学 报 63 581]
- [15] Chen G D, Wang L D, An B, Yang M, Cao D C, Liu G Q 2009
 Acta Phys. Sin. 58 1190 (in Chinese) [陈国栋、王六定、安博、杨 敏、曹得财、刘光清 2009 物理学报 58 1190]
- [16] Wang Y J, Wang L D, Yang M, Liu G Q, Yan C 2010 Acta Phys. Sin. 59 4950 (in Chinese) [王益军、王六定、杨 敏、 刘光清、严 诚 2010 物理学报 59 4950]

[17] Pati R, Zhang Y, Nayak S K, Ajayan P M 2002 Appl. Phys. Lett. 81 2638

[18] Roland C, Meunier V, Larade B, Guo H 2002 Phys. Rev. B 66 035332

[19] Datta S 1995 Electronic Transport in Mesoscopic Systems

(Cambridge:Cambridge University Press) p20

- [20] Perder J P, Zunger A 1981 Phys. Rev. B 23 5048
- [21] Taylor J, Guo H, Wang J 2001 Phys. Rev. B 63 245407
- [22] Brandbyge M, Mozos J L, Ordejón P, Taylor1 J, Stokbro1 K 2002 Phys. Rev. B 65 165401

Theoretical investigation on electron transport properties of single wall carbon nanotube with oxygen molecular absorption *

Zhao Pei¹⁾ Zheng Ji-Ming^{2)†} Chen You-Wei³⁾ Guo Ping¹⁾ Ren Zhao-Yu²⁾

1) (Department of Physics, Northwest University, Xi'an 710069, China)

2) (Institute of Photonics and Photo-technology, Northwest University, Xi'an 710069, China)

3) (Department of Network Engineering, Xi'an University of Post and Telecommunication, Xi'an 710121, China)

(Received 9 August 2010; revised manuscript received 14 September 2010)

Abstract

Electron transport properties of (4,4) single wall carbon nanotube as well as the nanotube with oxygen molecule absorption, are investigated by using first principles analysis. The results show that electron current through the nanotube with oxygen molecule absorption system increases linearly under low bias ranging from 0 to 1.1 V, while the bias is larger than 1.1 V, the current through this system increases slowly. It is also shown that absorbed oxygen molecule brings two kinds of influence on the properties of electron transport: first, the oxygen molecular absorbed states afford new channels to electron transport and enhance the transmission. Second, the oxygen molecular absorbed states spoil the nanotube's symmetry and enhance the electron scattering, so reduce the transmission.

Keywords: single wall carbon nanotube, oxygen molecular absorption, electron transport, non-equilibrium Green's functions

PACS: 85. 65. + h, 73. 63. - b, 85. 35. Kt

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Shaanxi Province, China (Grant No. 2009JQ1004), the Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10904123), and the Special Item Foundation of Educational Committee of Shaanxi Province of China (Grant No. 08JK471).

[†] Corresponding author. E-mail: zjm@ nwu. edu. cn